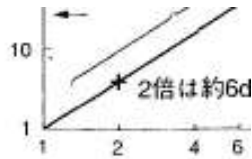
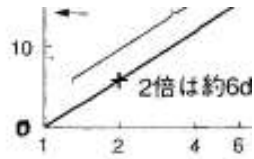
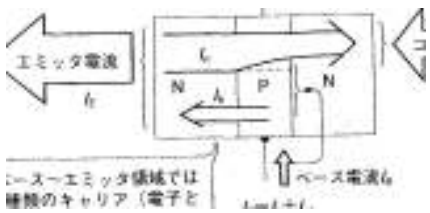
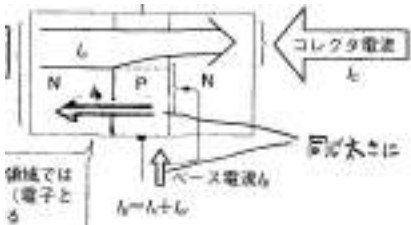


ページ,行, 図表	誤 (初版 1 刷中)	正
21 図 1-21	E _p 加電圧	印加電圧
24 図 1-24b)	高圧電力用のコンデンサ	高圧電力用コンデンサ
28 図 1-30	磁界は電流の流れを妨げる	磁界は電流の変化を妨げる
31 A1-13	$N = \sqrt{10\text{m}/100\text{n}} = 10$ 回	$N = \sqrt{100\mu/100\text{n}} = 10$ 回
38 図 1-41		
39 表 1-7	3 行目 低周波 dBm 1mV	低周波 dBm 1mW
46 図 2-4	囲み上 キャリアは電圧を印可すると動く	キャリアは電圧を印加すると動く
55 表 2-4	下 累積数 <100 <1,000 <100,000 <100,000	素子数 <100 <1,000 <10,000 <100,000
57 図 2-13		
73 A3-4	電流 I _c は 4V ÷ 1kΩ = 1mA、ベース電流 I _b は I _c ÷ hFE = 0.01mA、(3.1)式から…0.01mA…740kΩ	電流 I _c は 4V ÷ 1kΩ = 4mA、ベース電流 I _b は I _c ÷ hFE = 0.04mA、(3.1)式から…0.04mA…185kΩ
74 A3-5	電流 I _c は 4V ÷ 1kΩ = 1mA、ベース電流 I _b は I _c ÷ hFE = 0.01mA、…0.8V ÷ 1mA = 800Ω、…80kΩ…14kΩ…66kΩ R _A = 15kΩ、R _B = 68kΩ、R _C = 820Ω	電流 I _c は 4V ÷ 1kΩ = 4mA、ベース電流 I _b は I _c ÷ hFE = 0.04mA、…0.8V ÷ 4mA = 200Ω、…20kΩ…3.5kΩ…16.5kΩ R _A = 3.3kΩ、R _B = 15kΩ、R _C = 220Ω

<p>75 図 3-10</p>		
<p>86 図 4-5</p>		
<p>90 図 4-9</p>	<p>右 Ioss</p>	<p>IDSS</p>
<p>91 図 4-11</p>	<p>中 R10 R11 R12 R14</p>	<p>RE0 RE1 RE2 RE4</p>
<p>96 図 4-15</p>	<p>a) 抵抗比で出力電圧が決まる定電圧ソース</p> <p>$V_{out} = (V_2 - V_{be}) \cdot \frac{R_A \cdot R_B}{R_B}$</p>	<p>a) 抵抗比で出力電圧が決まる定電圧ソース</p> <p>$V_{out} = (V_2 + V_{be}) \cdot \frac{R_A + R_B}{R_B}$</p>
<p>96 6</p>	<p>り出力電圧が低下 (△の白部分) すると Q を上昇 (△の白部分) させて、出力電圧 負帰還に関する用語として、負帰還量</p>	<p>り出力電圧が低下 (△の白部分) すると Q を上昇 (△の白部分) させて、出力電圧 負帰還に関する用語として、負帰還量</p>
<p>97 図 4-16</p>	<p>左 12kΩ</p>	<p>1.2kΩ</p>
<p>104 15</p>	<p>オペアンプを使うための準備</p>	<p>オペアンプを使うための予備知識</p>
<p>110 図 5-6a)</p>		<p>Q7 エミッタ矢印、OUTPUT 黒丸</p>

114 図 5-9		
118 12	$\times R_{sS}$	$\times R_s$
121 13	$Av_2 = \dots$	$Av_2 = \dots \times$
123 図 5-16	上 714C	741C
136 図 5-24	中 20dB/oct	20dB/dec
137 図 5-25		
148 図 6-2		
156 13	ジスタの hFE E 上に小黑丸	ジスタの hFE E 上に小黑丸除去
164 図 6-14	右 トライアックが	サイリスタが
168 24 ～	2.5V になると…インピーダンスは大 ホトカプラをオフします	2.5V になると…インピーダンスは小 ホトカプラをオンします
172 10	鉄心	鉄芯
182 11	200～600 程度	200～600Ω 程度
187 図 6-38	右 電流 抵抗	熱流 熱抵抗

194 3	動作している確立」	動作している確率」
195 脚注	言い換えると、1000 時間当りに発生する故障の%表示です	%/1000Hr の表現もある
199 13	半導体チップ基盤が…単結晶基盤	半導体チップ基板が…単結晶基板
204 2	寿命時間をも止める	寿命時間を求める
208 1	リレーはポリウム	リレーやポリウム
216 図 8-2	: P (リン), As (ヒ素イオン) など	: P (リン), As (ヒ素) イオンなど
220 3	回路設計が	回路設計者が
224 2	di/dt を	di/dt と
235 図 8-22		<p>8µF 下 5Ω 付加</p>
252 図 9-9		